






	<h2 style="color: red;">FQD12N20TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD12N20TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD12N20TM.pdf 2.FQD12N20TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 16142 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD12N20TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16142 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	910pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD12N20TM ist neu im Original, Suche FQD12N20TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD12N20TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD12N20TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQD12N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK	 FQD12P10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK	 FQD12N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK	 FQD12P10 FAIRCHI FQD12P10 FAIRCHI
 FQD12N20LTM_SN00173 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V DPAK	 FQD12N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK	 FQD12N20LTM_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK	 FQD12N20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD10N20L	↔ FQD10N20LTF	⇒ FQD10N20LTF	D FQD10N20LTM	⇒ FQD10N20LTM
⊣ FQD10N20TF	⊗ FQD10N20TF	D FQD10N20TM	⇒ FQD10N20TM	⇒ FQD11P06
⊗ FQD11P06-NL	⊣ FQD11P06TF	⊗ FQD11P06TF	↔ FQD11P06TM	⇒ FQD11P06TM
D FQD12N10	⊗ FQD12N20	⊣ FQD12N20L	⊗ FQD12N20LTF	⇒ FQD12N20LTF
⇒ FQD12N20LTM	↔ FQD12N20LTM	⊗ FQD12N20TF	⊣ FQD12N20TF	⇒ FQD12N20TM
↔ FQD12P10	⇒ FQD12P10TF	D FQD12P10TF	⊗ FQD12P10TM	⊣ FQD12P10TM
⊗ FQD13N06	D FQD13N06L	⇒ FQD13N06LTF	↔ FQD13N06LTF	⇒ FQD13N06LTM
⊣ FQD13N06LTM	⊗ FQD13N06LTM-NL	↔ FQD13N06TF	⇒ FQD13N06TF	⇒ FQD13N06TM
⊗ FQD13N06TM	⊣ FQD13N10	⊗ FQD13N10L	D FQD13N10LTF	⇒ FQD13N10LTF
↔ FQD13N10LTM	⊗ FQD13N10LTM	⊣ FQD13N10LTM-NL	⊗ FQD13N10TM	⇒ FQD13N10TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited